

PrimePACK™3+ B-Serien Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material**Eigenschaften**

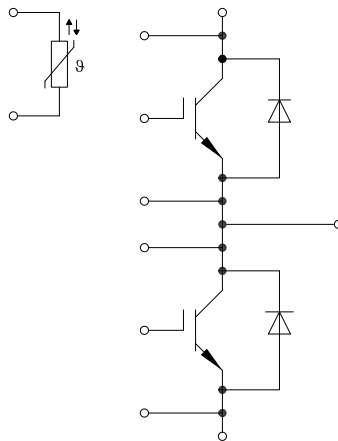
- Elektrische Eigenschaften
 - $V_{CES} = 2300\text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 1800\text{ A} / I_{CRM} = 3600\text{ A}$
 - Trenchstop™ IGBT7
 - $T_{vj\text{ op}} = 150^{\circ}\text{C}$
 - Überlastbetrieb bis zu 175°C
 - Niedriges V_{CESat}
 - Niedrige Schaltverluste
 - Hohe Stromdichte
 - Niederinduktives Design
- Mechanische Eigenschaften
 - Gehäuse mit $CTI > 400$
 - Große Luft- und Kriechstrecken
 - Hohe Leistungsdichte
 - Thermisches Interface Material bereits aufgetragen

**Potenzielle Anwendungen**

- 3-Level-Applikationen
- Solar Anwendungen

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung

Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	Gehäuse	3
2	IGBT, Wechselrichter	3
3	Diode, Wechselrichter	5
4	IGBT, 3-Level	6
5	Diode, 3-Level	8
6	NTC-Widerstand	9
7	Kennlinien	10
8	Schaltplan	16
9	Gehäuseabmessungen	17
10	Modul-Label-Code	18
	Änderungshistorie	19
	Disclaimer	20

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, $f = 50$ Hz	4.0	kV
Material Modulgrundplatte			Cu	
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kühlkörper	36.0	mm
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kontakt	28.0	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kühlkörper	21.0	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kontakt	19.0	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	CTI		> 400	

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Modulstreuinduktivität	L_{sCE}			10		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{AA'+CC'}$	$T_H = 25$ °C, pro Schalter		0.09		mΩ
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	$T_H = 25$ °C, pro Schalter		0.1		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}		-40		150	°C
Höchstzulässige Bodenplattenbetriebstemperatur	T_{BPmax}				150	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M5, Schraube	3	6	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M4, Schraube	1.8	2.1	Nm
			M8, Schraube	8	10	
Gewicht	G			1400		g

2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		$T_{vj} = 25$ °C	2300	V
Implementierter Kollektor-Strom	I_{CN}			1800	A
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj max} = 150$ °C	$T_H = 45$ °C	1420	A

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 3 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj\,op}$	3600	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}		± 20	V

Tabelle 4 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\,sat}$	$I_C = 1800\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1.80	2.26	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	2.15	2.94	
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	2.25	3.13	
Gate-Schwellenspannung	V_{GETh}	$I_C = 49.5\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ °C}$	5.15	5.80	6.45	V
Gateladung	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CC} = 1200\text{ V}$		14.6		μC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.96		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		225		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		0.54		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	$V_{CE} = 2300\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$			30	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	$I_C = 1800\text{ A}, V_{CC} = 1200\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.1\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.530		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	0.550		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	0.560		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	$I_C = 1800\text{ A}, V_{CC} = 1200\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.1\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.072		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	0.078		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	0.083		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	$I_C = 1800\text{ A}, V_{CC} = 1200\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 1.5\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.955		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1.050		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	1.080		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	$I_C = 1800\text{ A}, V_{CC} = 1200\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 1.5\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.770		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1.020		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	1.100		
Einschaltzeit (ohmsche Last)	t_{on_R}	$I_C = 500\text{ A}, V_{CC} = 2000\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.1\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.79		μs

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	$I_C = 1800\text{ A}$, $V_{CC} = 1200\text{ V}$, $L_\sigma = 20\text{ nH}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 0.1\ \Omega$, $di/dt = 17500\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	570		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	815		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	915		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	$I_C = 1800\text{ A}$, $V_{CC} = 1200\text{ V}$, $L_\sigma = 20\text{ nH}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 1.5\ \Omega$, $dv/dt = 4050\text{ V}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	885		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1160		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	1240		
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\text{ V}$, $V_{CC} = 1200\text{ V}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_P \leq 7\ \mu\text{s}$, $T_{vj} = 150\text{ °C}$	8000		A
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro IGBT, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			27.4	K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\ op}$		-40		150	°C

Anmerkung: R_{thJH} Maximalwert ist gültig für $T_C = 105\text{ °C}$.

3 Diode, Wechselrichter

Tabelle 5 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	2300	V
Dauergleichstrom	I_F		1800	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	$t_P = 1\text{ ms}$	3600	A
Grenzlastintegral	I^2t	$t_P = 10\text{ ms}$, $V_R = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125\text{ °C}$	kA ² s
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	
Spitzenverlustleistung	P_{RQM}	$T_{vj} = 150\text{ °C}$	2700	kW

Tabelle 6 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 1800\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	3.25	3.64	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	3.00	3.33	
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	2.95	3.22	

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 6 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Rückstromspitze	I_{RM}	$V_{CC} = 1200 \text{ V}, I_F = 1800 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 17500 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	1700		A
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	1870		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	1880		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	$V_{CC} = 1200 \text{ V}, I_F = 1800 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 17500 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	300		μC
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	625		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	740		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	$V_{CC} = 1200 \text{ V}, I_F = 1800 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 17500 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	240		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	500		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	590		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			53.6	K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\text{ op}}$		-40		150	$^\circ\text{C}$

Anmerkung: R_{thJH} Maximalwert ist gültig für $T_C = 90 \text{ }^\circ\text{C}$.

4 IGBT, 3-Level

Tabelle 7 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	2300	V
Implementierter Kollektor-Strom	I_{CN}			1800	A
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj\text{ max}} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	$T_H = 45 \text{ }^\circ\text{C}$	1420	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj\text{ op}}$		3600	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}			± 20	V

Tabelle 8 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 1800\ A, V_{GE} = 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		1.80	2.26	V
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		2.15	2.94	
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		2.25	3.13	
Gate-Schwellenspannung	V_{GETh}	$I_C = 49.5\ mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\ ^\circ C$		5.15	5.80	6.45	V
Gateladung	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\ V, V_{CC} = 1200\ V$			14.6		μC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0.96		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			225		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			0.54		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	$V_{CE} = 2300\ V, V_{GE} = 0\ V$	$T_{vj} = 125\ ^\circ C$			30	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	$V_{CE} = 0\ V, V_{GE} = 20\ V, T_{vj} = 25\ ^\circ C$				400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	$I_C = 1800\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.555		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.580		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.590		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	$I_C = 1800\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.190		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.205		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.215		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	$I_C = 1800\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 1.5\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.885		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.955		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.980		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	$I_C = 1800\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 1.5\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.630		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.875		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.930		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	$I_C = 1800\ A, V_{CC} = 600\ V, L_\sigma = 50\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 0.1\ \Omega, di/dt = 6700\ A/\mu s (T_{vj} = 150\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		240		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		380		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		430		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	$I_C = 1800\ A, V_{CC} = 600\ V, L_\sigma = 50\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 1.5\ \Omega, dv/dt = 3150\ V/\mu s (T_{vj} = 150\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		490		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		630		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		665		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro IGBT, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material				27.4	K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\ op}$			-40		150	$^\circ C$

Anmerkung: R_{thJH} Maximalwert ist gültig für $T_C = 105\text{ °C}$.

5 Diode, 3-Level

Tabelle 9 **Höchstzulässige Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	2300	V
Dauergleichstrom	I_F		1800	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	$t_P = 1\text{ ms}$	3600	A

Tabelle 10 **Charakteristische Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 1800\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	3.25	3.64	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	3.00	3.33	
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	2.95	3.22	
Rückstromspitze	I_{RM}	$V_{CC} = 600\text{ V}$, $I_F = 1800\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 8200\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1120		A
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1450		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	1530		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	$V_{CC} = 600\text{ V}$, $I_F = 1800\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 8200\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	295		μC
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	580		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	665		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	$V_{CC} = 600\text{ V}$, $I_F = 1800\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 8200\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	170		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	320		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	365		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			53.6	K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\text{ op}}$		-40		150	°C

Anmerkung: Dynamische Daten für 3-Level gelten in Verbindung mit FF2400RB12IP7 Modul.

$T_{vj\text{ op}}$ bis zu 175 °C ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN2021-11 zu entnehmen.

R_{thJH} Maximalwert ist gültig für $T_C = 90\text{ °C}$.

Für Anwendungen im Chopperbetrieb und andere Bedingungen, die einen Sperrbetrieb über längere Zeit erfordern, sprechen Sie bitte mit Ihrem Vertriebspartner für Infineon Produkte.

6 NTC-Widerstand

Tabelle 11 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Nennwiderstand	R_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$		5		kΩ
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100\text{ °C}, R_{100} = 493\text{ Ω}$	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3433		K

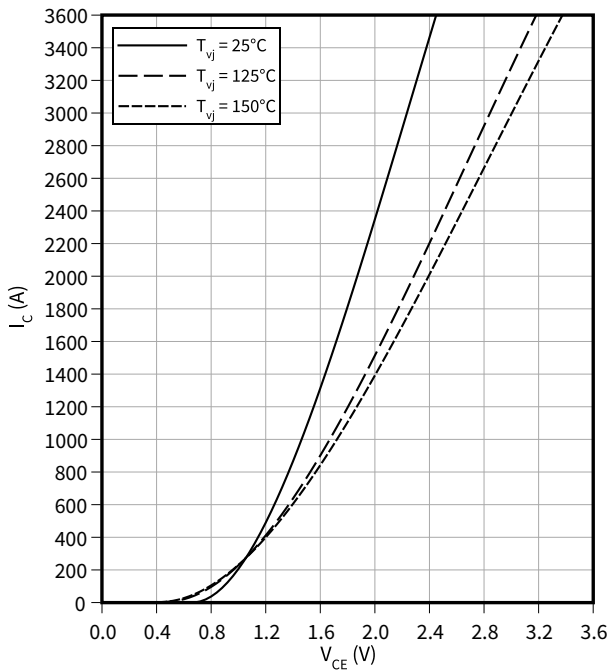
Anmerkung: Eine detaillierte Beschreibung der NTC-Eigenschaften finden Sie in der AN2009-10, Kapitel 4.

7 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$

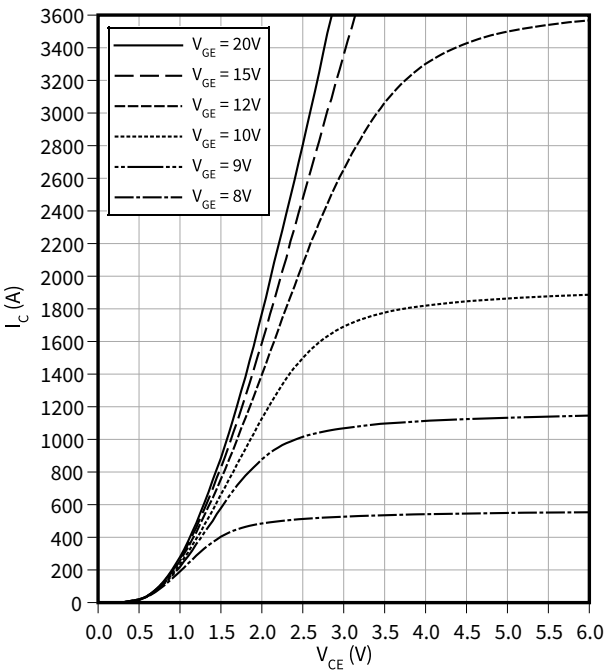
$V_{GE} = 15\text{ V}$



Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$

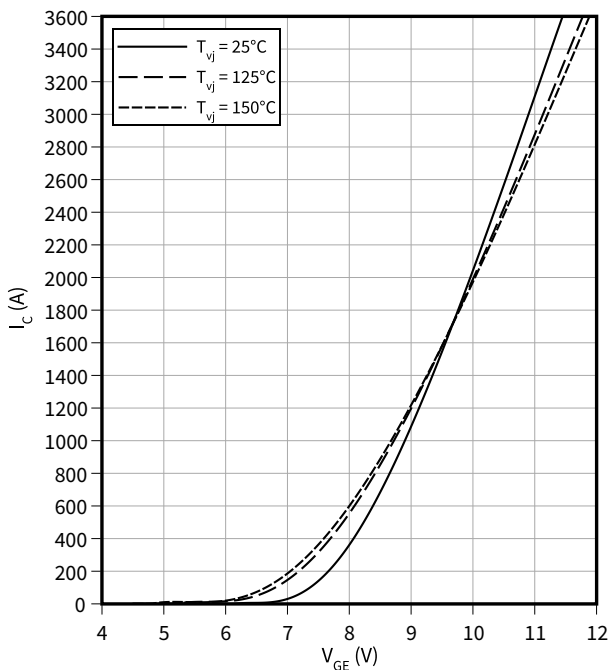
$T_{vj} = 150\text{ °C}$



Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{GE})$

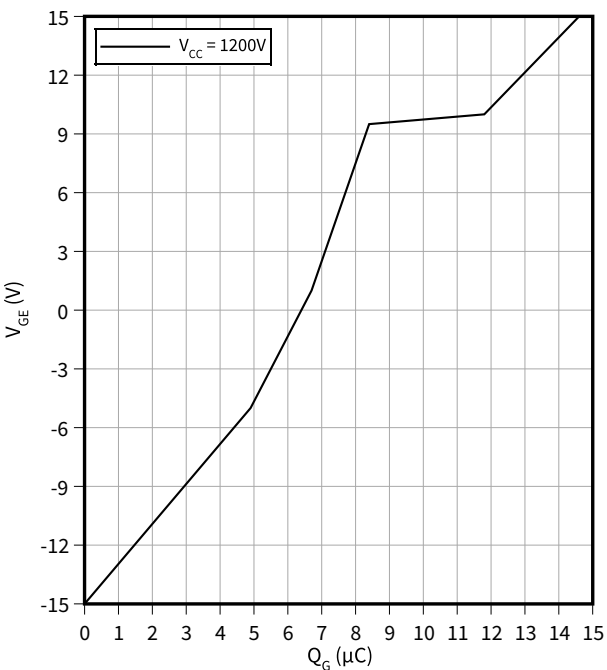
$V_{CE} = 20\text{ V}$



Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

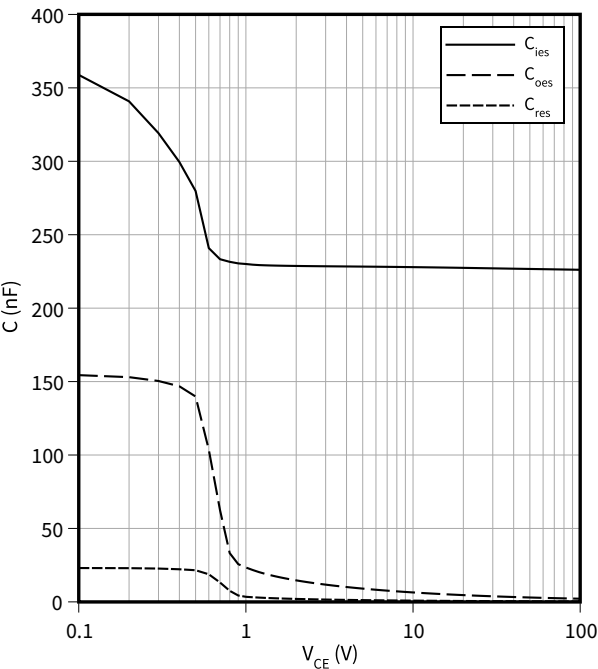
$V_{GE} = f(Q_G)$

$I_C = 1800\text{ A}, T_{vj} = 25\text{ °C}$



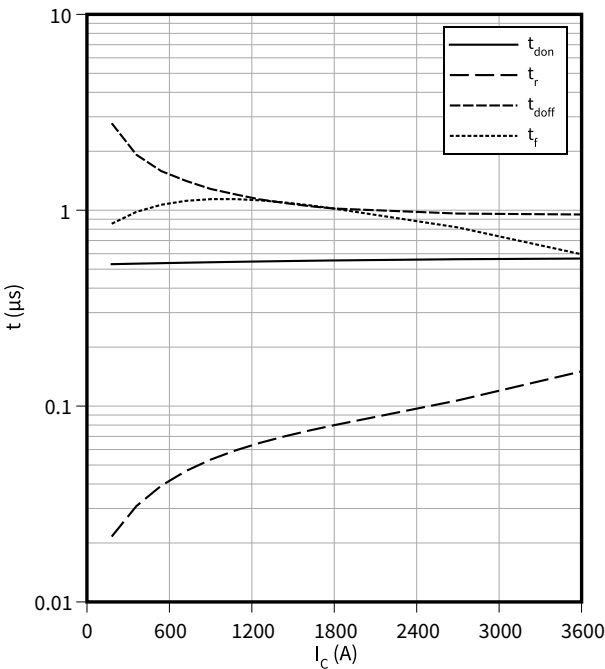
Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$C = f(V_{CE})$
 $f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$



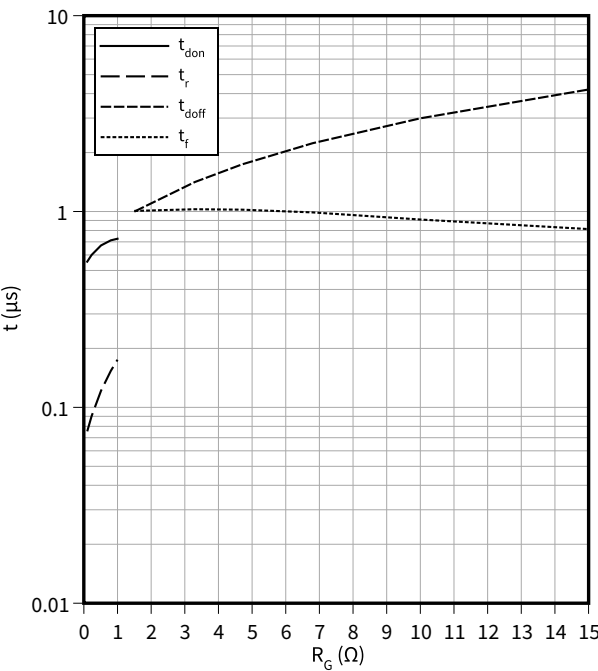
Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(I_C)$
 $R_{Goff} = 1.5 \text{ } \Omega, R_{Gon} = 0.1 \text{ } \Omega, V_{CC} = 1200 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 150 \text{ }^{\circ}\text{C}$



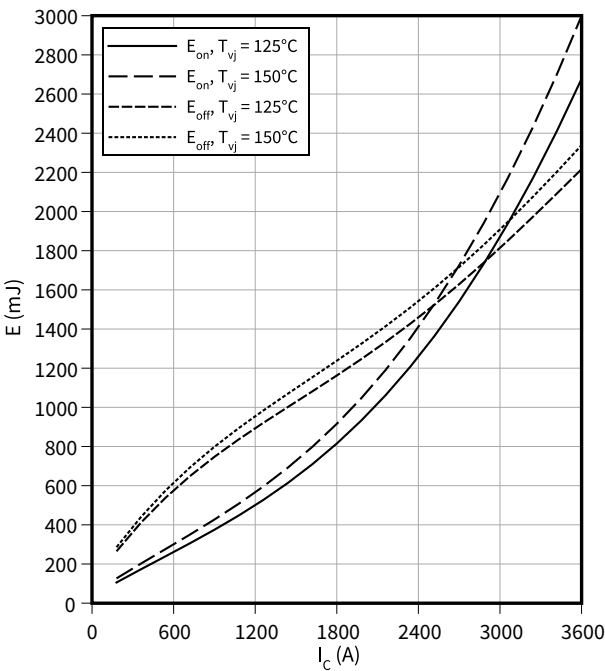
Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 1800 \text{ A}, T_{vj} = 150 \text{ }^{\circ}\text{C}, V_{CC} = 1200 \text{ V}$



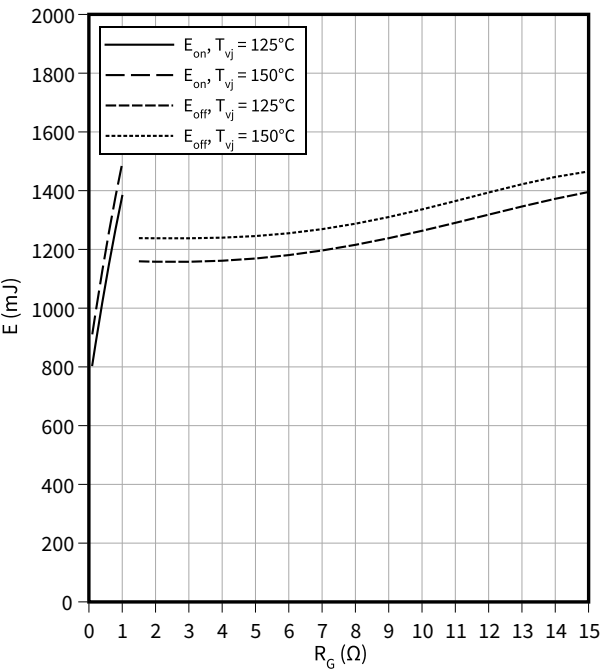
Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(I_C)$
 $R_{Goff} = 1.5 \text{ } \Omega, R_{Gon} = 0.1 \text{ } \Omega, V_{CC} = 1200 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$



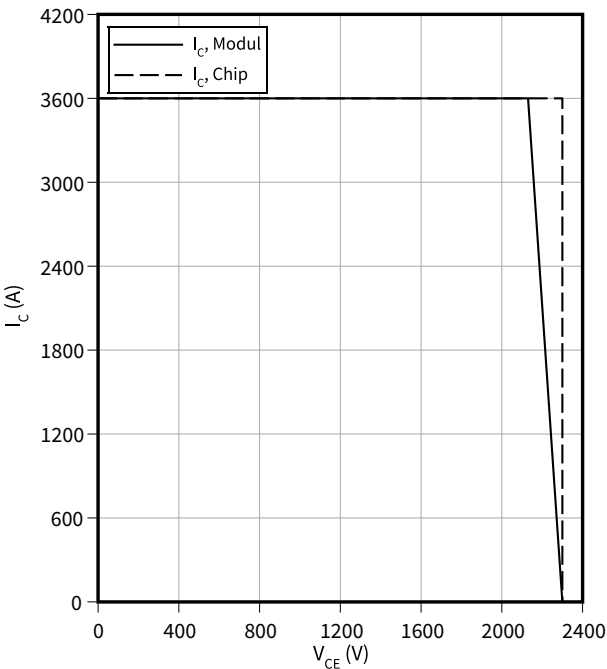
Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(R_G)$
 $I_C = 1800\text{ A}$, $V_{CC} = 1200\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$



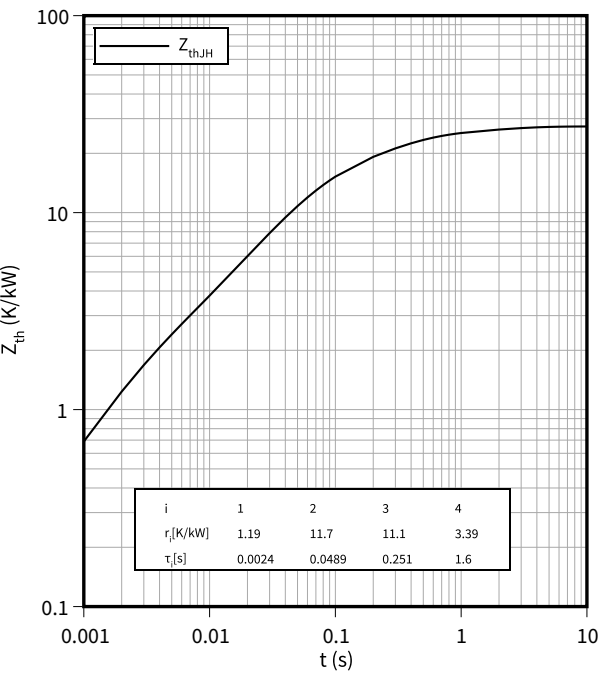
Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$
 $R_{Goff} = 1.5\text{ }\Omega$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$



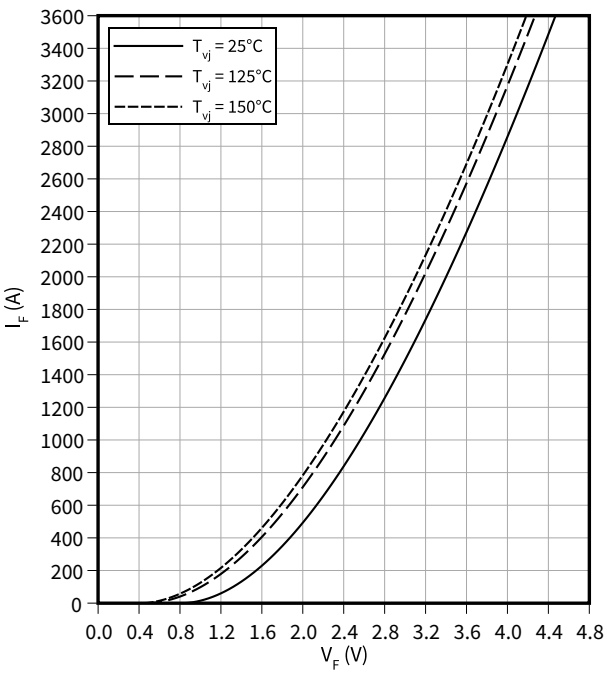
Transienter Wärmewiderstand, IGBT, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$



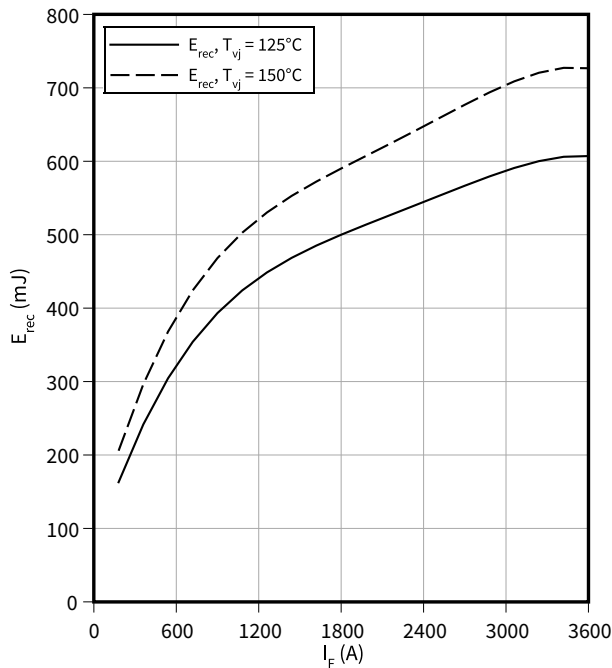
Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Wechselrichter

$I_F = f(V_F)$



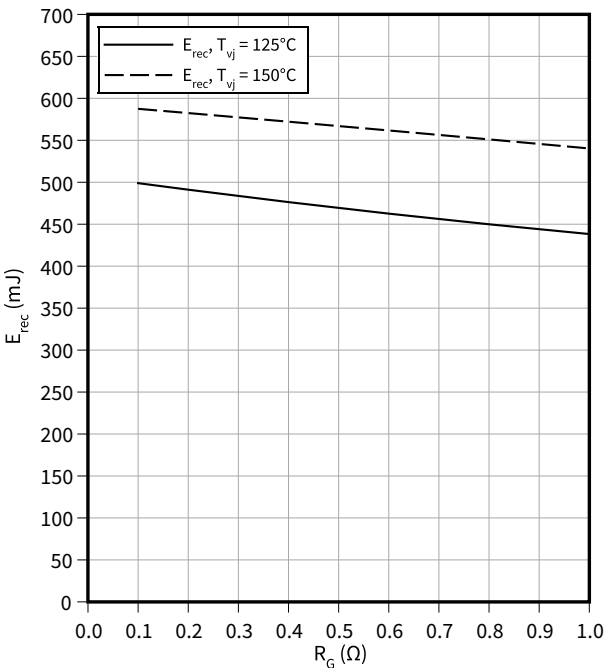
Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(I_F)$
 $V_{CE} = 1200\text{ V}$, $R_{Gon} = R_{Gon}(IGBT)$



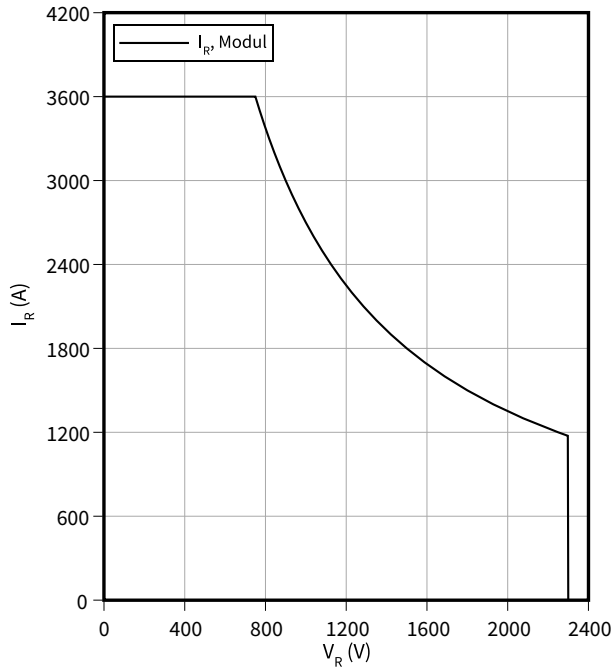
Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 1800\text{ A}$, $V_{CE} = 1200\text{ V}$



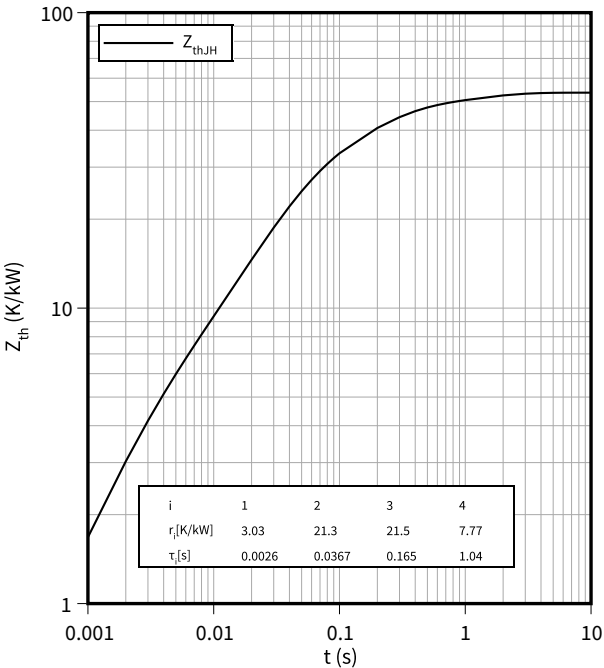
Sicherer Arbeitsbereich (SOA), Diode, Wechselrichter

$I_R = f(V_R)$
 $T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$



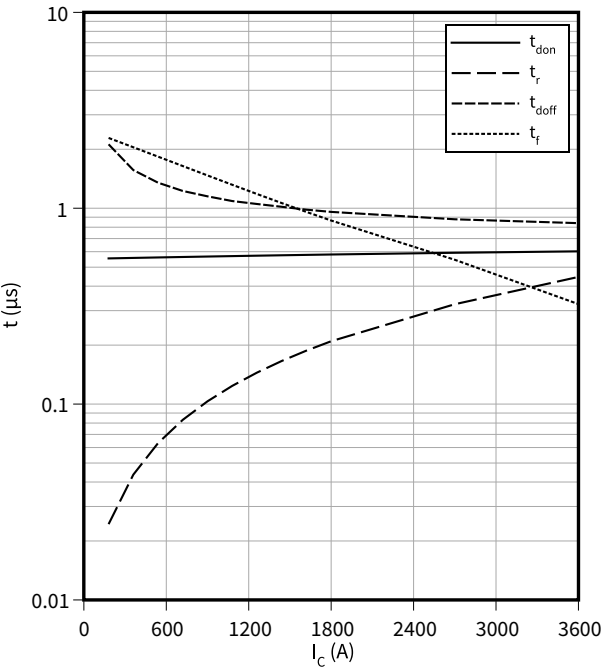
Transienter Wärmewiderstand, Diode, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$



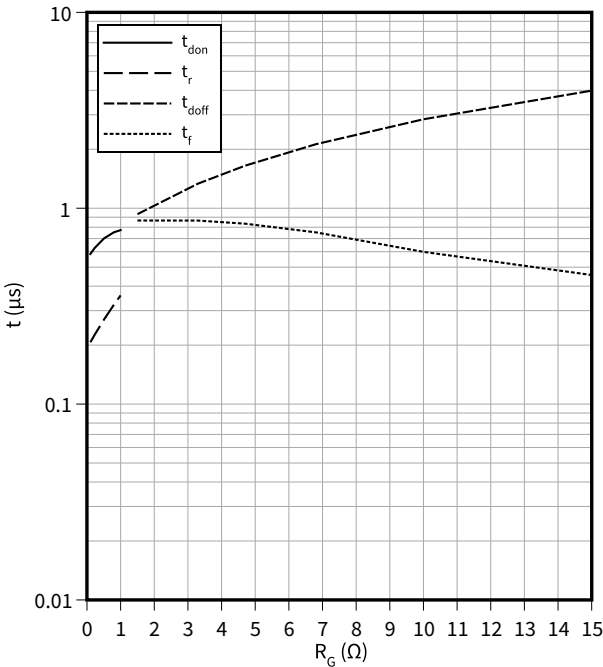
Schaltzeiten (typisch), IGBT, 3-Level

$t = f(I_C)$
 $R_{Goff} = 1.5 \, \Omega$, $R_{Gon} = 0.1 \, \Omega$, $V_{CC} = 600 \, V$, $V_{GE} = \pm 15 \, V$, $T_{vj} = 150 \, ^\circ C$



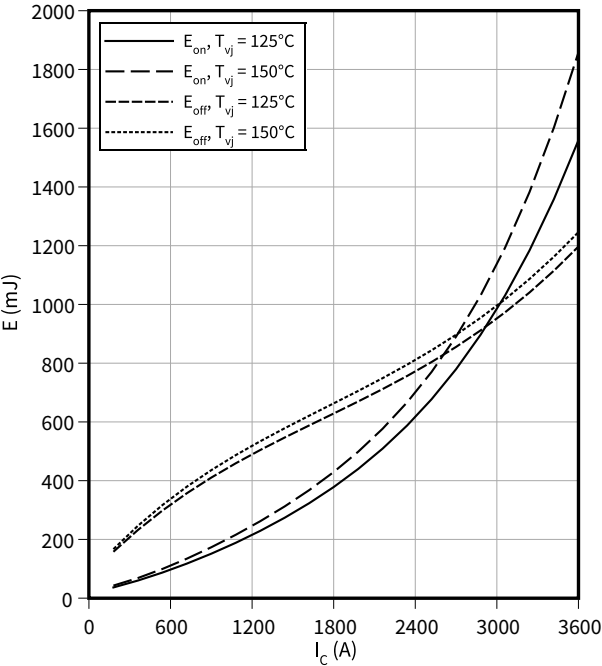
Schaltzeiten (typisch), IGBT, 3-Level

$t = f(R_G)$
 $I_C = 1800 \, A$, $V_{CC} = 600 \, V$, $V_{GE} = \pm 15 \, V$, $T_{vj} = 150 \, ^\circ C$



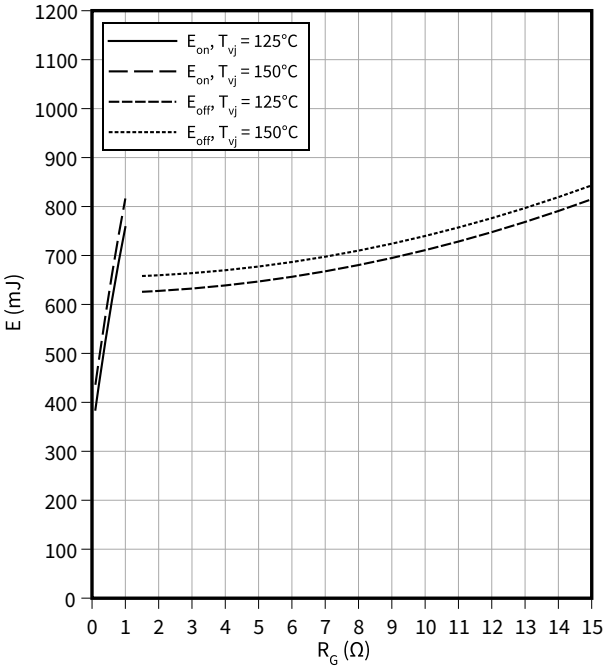
Schaltverluste (typisch), IGBT, 3-Level

$E = f(I_C)$
 $R_{Goff} = 1.5 \, \Omega$, $R_{Gon} = 0.1 \, \Omega$, $V_{CC} = 600 \, V$, $V_{GE} = \pm 15 \, V$



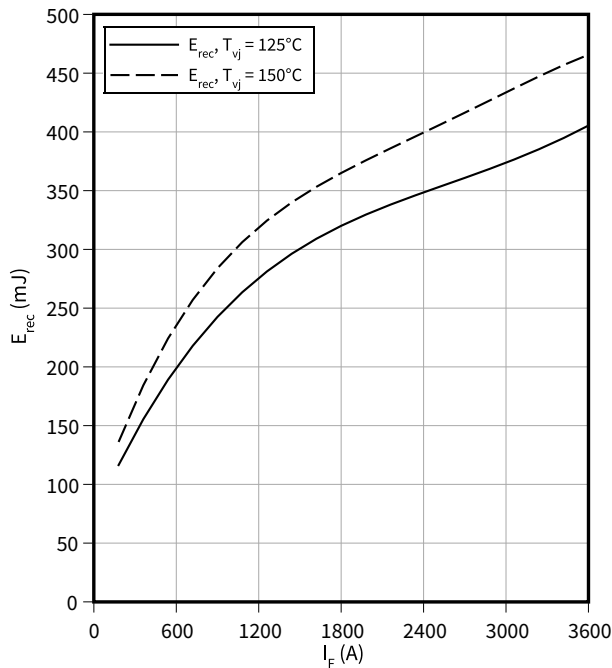
Schaltverluste (typisch), IGBT, 3-Level

$E = f(R_G)$
 $I_C = 1800 \, A$, $V_{CC} = 600 \, V$, $V_{GE} = \pm 15 \, V$



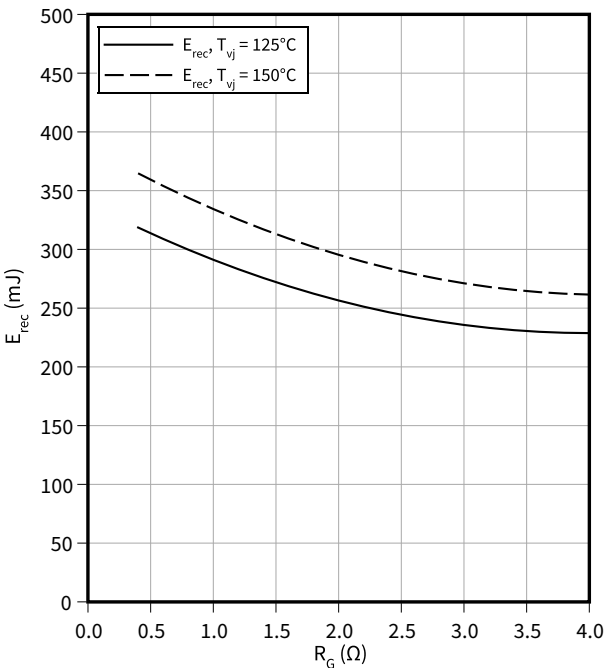
Schaltverluste (typisch), Diode, 3-Level

$E_{rec} = f(I_F)$
 $V_{CE} = 600\text{ V}$, $R_{Gon} = R_{Gon}(IGBT)$



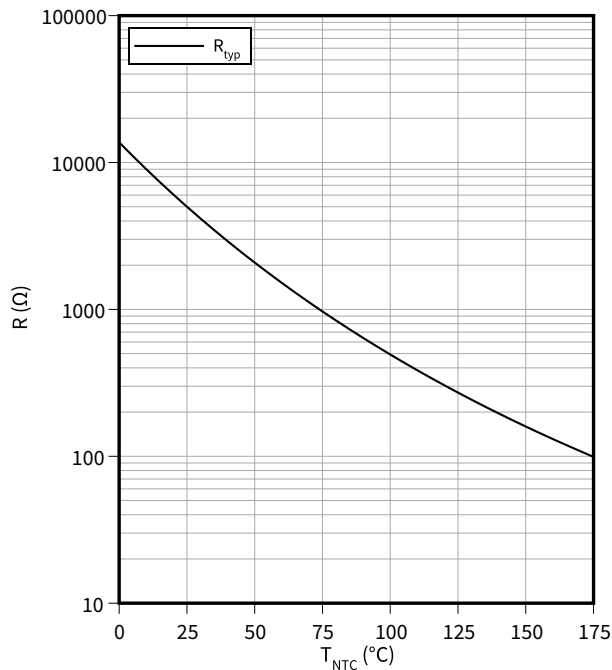
Schaltverluste (typisch), Diode, 3-Level

$E_{rec} = f(R_G)$
 $V_{CE} = 600\text{ V}$, $I_F = 1800\text{ A}$



Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$R = f(T_{NTC})$



8 Schaltplan

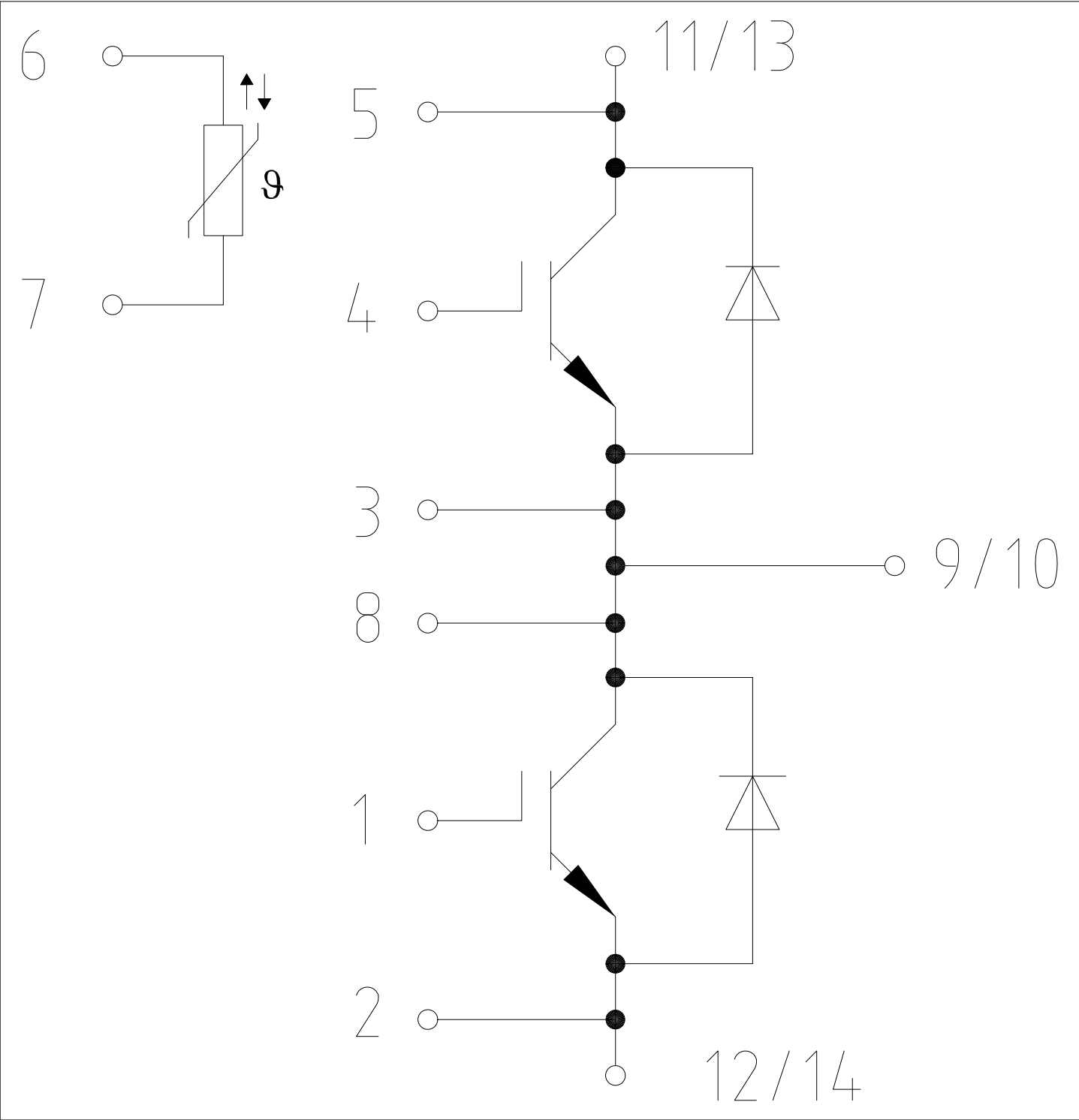


Abbildung 1

9 Gehäuseabmessungen

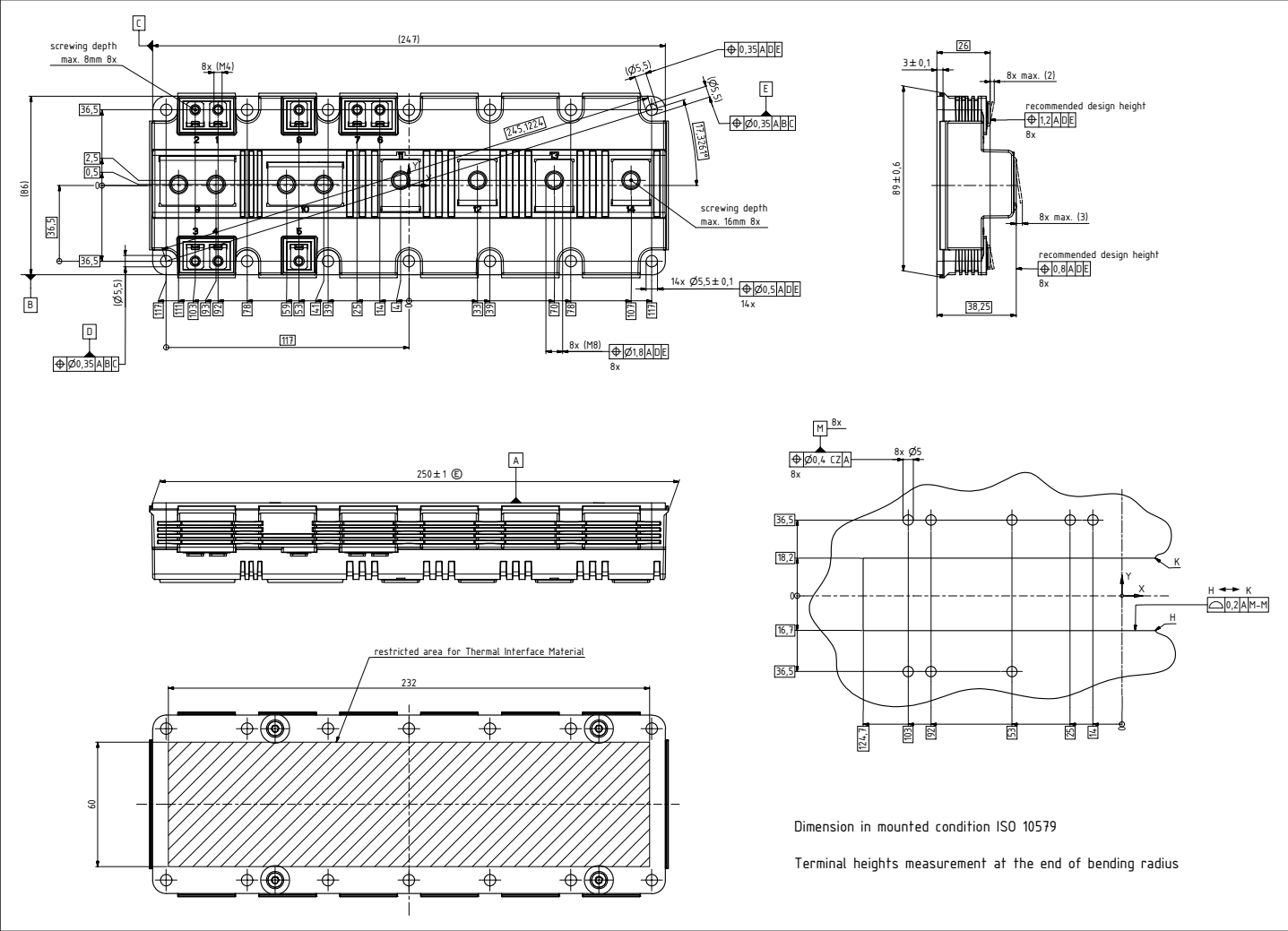


Abbildung 2

10 Modul-Label-Code

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example	 7154914284655054991153071549142846550549911530		

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
1.00	2022-05-03	Final datasheet
1.10	2023-07-13	Final datasheet - Correction/ addition of capacity characteristics; Updates of commentary

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2023-07-13

Published by

**Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2023 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

**Do you have a question about any
aspect of this document?**

Email: erratum@infineon.com

**Document reference
IFX-ABD865-002**

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht gemäß den AEC Q100 oder AEC Q101 Dokumenten des Automotive Electronics Council qualifiziert ist.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.